АКУСТИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

УДК 534.232

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ МАГНИТОУПРУГИХ ВОЛН В ГЕМАТИТЕ

Т. А. Маматова, В. Г. Прокошев

(кафедра акустики)

В антиферромагнетиках с магнитной анизотропией типа «легкая плоскость» магнитоупругая связь приводит к значительной перенормировке упругих модулей [1—3]. Среди таких материалов особое место занимает гематит α -Fe₂O₃. Скорость магнитоупругих волн в гематите изменяется на десятки процентов при приложении внешнего магнитного поля [3]. Вместе с изменением скорости происходит, вообще говоря, и изменение поляризации упругих волн. В настоящей работе исследованы поляризационные эффекты при распространении упругих волн в гематите.

Распространение объемных акустических волн в кристаллах описывается матричным уравнением Грина—Кристоффеля [4]

$$(\Gamma_{ij} - \rho v^2 \delta_{ij}) u_j = 0, \tag{1}$$

где $\Gamma_{ij} = c_{ijkl}n_kn_l$ — тензор Грина—Кристоффеля, c_{ijkl} — тензор упругих модулей, n_k — компоненты единичного вектора в направлении волновой нормали, ρ — плотность кристалла, v — фазовая скорость, δ_{ij} символ Кронекера, u_i — компоненты вектора смещения. Для описания упругих волн в гематите компоненты тензора $\hat{\Gamma}$ должны быть изменены с учетом магнитоупругой связи. Эффективные упругие модули гематита можно записать в виде $[5]: \hat{c}' = \hat{c} - \Delta \hat{c}$, где $\Delta \hat{c}$ — тензор, определяемый магнитоупругим взаимодействием:

$$\Delta c = \frac{4H_E (\widehat{1Bm})^2}{M_0 (\omega_0/\gamma)^2},$$

$$(\omega_0/\gamma)^2 = H (H + H_D) + 2H_E H_{ms}.$$
(2)

Здесь H_E — обменное поле, M_0 — намагниченность насыщения подрешеток, $\mathbf{I} = \mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2/(2M_0)$ — вектор антиферромагнетизма, \hat{B} — тензор магнитоупругих констант, \mathbf{m} — единичный вектор в направлении ферромагнитного вектора $\boldsymbol{\mu} = (\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2)/(2M_0)$, ω_0 — частота квазиферромагнитной моды антиферромагнитного резонанса, γ — магнитомеханическое отношение, H — внешнее поле, H_D — эффективное поле взаимодействия Дзялошинского, H_{ms} — поле спонтанной магнитострикции. В общем случае, для произвольного направления распространения и произвольного направления внешнего поля, все компоненты тензора $\hat{\Gamma}$ отличны от нуля, так что уравнение (1) может быть решено численными методами.

При распространении вдоль тригональной оси z гематита ($n_1=0$, $n_2=0$, $n_3=1$) тензор $\hat{\Gamma}$ с учетом соотношений (2) имеет следующие ненулевые компоненты:

$$\Gamma_{11} = c_{44} - \Delta c \cos^2 2\varphi$$
,

59

$$\Gamma_{12} = \Gamma_{21} = \Delta c \sin 2\varphi \cos 2\varphi, \tag{3}$$

$$\Gamma_{22} = c_{44} - \Delta c \sin^2 2\varphi,$$

 $\Gamma_{33} = c_{33},$

где $\Delta c = H_E \cdot 4B^2{}_{14}\gamma^2/(M_0\omega_0{}^2)$, ϕ — угол между направлением внешнего поля и кристаллографической осью **х** (ось второго порядка). Тогда легко получить, что скорости упругих волн в данном направлении равны

$$v_1 = \left(\frac{c_{44} - \Delta c}{\rho}\right)^{1/2},$$

$$v_2 = \left(\frac{c_{44}}{\rho}\right)^{1/2},$$

$$v_3 = \left(\frac{c_{33}}{\rho}\right)^{1/2},$$
(4)

где v_3 — скорость продольной волны, v_1 и v_2 — скорости поперечных волн. Из (4) можно видеть, что в рассматриваемом случае только одна поперечная мода v_1 будет связана с магнитной подсистемой. Подставляя скорости в уравнение (1), получим, что направление поляризации сдвиговых волн определяется направлением внешнего поля в базисной плоскости. Вектор смещения сдвиговой магнитоупругой моды направлен под углом 2 ϕ к оси второго порядка. Единичные векторы поляризации нормальных сдвиговых мод равны

$$\mathbf{u_1} = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi \\ \sin 2\varphi \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u_2} = \begin{pmatrix} -\sin 2\varphi \\ \cos 2\varphi \end{pmatrix}.$$
(5)

Волна произвольной поляризации может быть представлена как сумма нормальных мод, а результирующий вектор смещения в произвольной точке на пути распространения будет зависеть от фазовых соотношений между нормальными модами и, следовательно, от величины и направления внешнего магнитного поля.

При распространении вдоль оси **x** $(n_1=1, n_2=n_3=0)$ и ориентации поля под произвольным углом к кристаллографическим осям в базисной плоскости все компоненты тензора $\widehat{\Gamma}$ отличны от нуля. Если магнитное поле параллельно оси **x** или **y**, тензор $\widehat{\Gamma}$ имеет следующие ненулевые компоненты:

$$\begin{split} \Gamma_{11} &= c_{11}; \ \Gamma_{22} = c_{66}' = c_{66} - \Delta c_{1}; \\ \Gamma_{23} &= \Gamma_{32} = c_{14}' = c_{14} - \frac{1}{2} \ \Delta c_{3}; \\ \Gamma_{33} &= c_{44}' = c_{44} - \Delta c_{2}; \\ \Delta c_{1} &= \frac{H_{E} (B_{11} - B_{12})^{2}}{M_{0} (\omega_{0}/\gamma)^{2}}; \ \Delta c_{2} &= \frac{H_{E} (2B_{14})^{2}}{M_{0} (\omega_{0}/\gamma)^{2}}; \ \Delta c_{3} = \frac{4H_{E} B_{14} (B_{11} - B_{12})}{M_{0} (\omega_{0}/\gamma)^{2}} \end{split}$$

Скорости в этом направлении равны

$$v_1 = \left(\frac{c_{11}}{\rho}\right)^{1/2} ,$$

$$2\rho v_2^2 = c_{66}^2 + c_{44}^2 + \sqrt{(c_{66}^2 - c_{44}^2)^2 + 4c_{14}^2}, \qquad (6)$$

$$2\rho v_3^2 = \dot{c_{66}} + c_{44} - \sqrt{(\dot{c_{66}} - \dot{c_{44}})^2 + 4c'_{14}^2},$$

 v_1 — скорость продольной волны, v_2 , v_3 — скорости поперечных волн. Таким образом, из (6) можно видеть, что скорости обеих поперечных мод зависят от внешнего поля. Поляризация определяется соотношением упругих модулей

$$tg \psi = \frac{u_y}{u_z} = \frac{2c_{14}}{c_{66}' - c_{44}' + \sqrt{(c_{66}' - c_{44}')^2 + 4c_{14}'^2}}$$

здесь ψ — угол наклона вектора смещения в медленной поперечной моде относительно оси z. Расчет показывает, что при изменении поля от 4 до 0,1 кЭ угол ψ меняется от 30 до 20°. Если внешнее поле направлено под углом 45° к осям x и y, компоненты $\widehat{\Gamma}$ имеют вид

$$\Gamma_{11} = c'_{11} = c_{11} - \Delta c_1;$$

$$\Gamma_{22} = c_{66}; \quad \Gamma_{33} = c_{44};$$

$$\Gamma_{23} = \Gamma_{32} = c_{14}.$$

В этом случае сдвиговые волны в линейном приближении не связаны с магнитной подсистемой, но продольная волна является магнитоупругой.

При распространении вдоль оси у, если внешнее поле направлено под углом 45° к осям х и у, существует поперечная волна с поляризацией вдоль х, имеющая скорость $v_1 = (c_{66}/\rho)^{1/2}$, и квазипродольная и квазипоперечная волны, связанные с матнитной подсистемой, скорости которых v_2 и v_3 соответственно определяются формулами

$$2\rho v_2^2 = c_{11}' + c_{44}' + \sqrt{(c_{11} - c_{44}')^2 + 4c'_{14}^2},$$

$$2\rho v_3^2 = c_{11}' + c_{44}' - \sqrt{(c_{11} - c_{14}')^2 + 4c'_{14}^2}.$$

Поляризация этих волн определяется углом наклона вектора смещения относительно оси у:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{u_y}{u_z} = \frac{2c_{14}}{c_{11}' - c_{44}' + \sqrt{(c_{11}' - c_{44}')^2 + 4c_{14}'^2}}$$

и, как видно, зависит от величины внешнего поля. При изменении поля от 4 до 0,1 кЭ угол в меняется от 5 до 8°.

Экспериментальное исследование проводилось на синтетических образцах гематита, имеющих размеры $4 \times 8 \times 2$ и $7 \times 3 \times 2$ мм вдоль осей х, у, z соответственно. Использовалась обычная импульсная методика. Для возбуждения упругих волн применялись кварцевые пьезоэлектрические преобразователи. Измерения осуществлялись в диапазоне частот от 10 до 45 МГц. Длительность импульсов была не более 0,5 мкс, что позволяло избежать интерференционных эффектов при отражении. Относительные изменения скорости $\Delta v/v$ регистрировались с точностью 0,2%.

На рис. 1 показаны зависимости скоростей магнитоупругих волн от напряженности магнитного поля. В направлении тригональной оси

z измерения проведены для произвольной поляризации сдвиговой волны, при этом выбиралась ориентация поля в соответствии с формулами (5). Максимальное относительное изменение скорости составило более



Рис. 1. Зависимость скорости магнитоупругих волн от напря женности внешнего магнитного поля $(1 - n \| y, 2 - n \| z, 3 - n \| x)$



Рис. 2. Зависимость затухания магнитоупругих волн от напряженности внешнего магнитного поля (1 — 45 МГц; 2 — 10 МГц; 3 — 45 МГц, немагнитоупругая мода,

40%. На трафике также приведены изменения скорости магнитоупругих волн вдоль осей x и y (поляризация параллельна z). Для этих направлений уменьшение магнитного поля приводило к интерференции нормальных мод на выходном преобразователе, которая затрудняла измерение скорости при напряженности менее 1 кЭ. Изменение скорости, полученное в эксперименте, составило более 10%.

На рис. 2 показаны графики зависимости затухания малнитоупругих волн вдоль оси z от напряженности поля для одного из образцов. На этом же рисунке приводится затухание немагнитоупругой сдвиговой моды (поляризация параллельна оси x, $\varphi = 45^{\circ}$). Для того чтобы убедиться в том, что зависимости правильно передают характер затухания, проведены эксперименты, в которых приемный преобразователь повернут на 90° относительно излучающего. Было обнаружено, что при уменьшении поля амплитуда перпендикулярной компоненты становится сравнимой с амплитудой параллельной компоненты поляризации. в то время как в соответствии с (3)-(5) поляризация не зависит от величины поля. Напряженность, при которой уже необходимо учитывать изменение поляризации, отмечена на графике стрелкой. Этот эффект может быть объяснен неоднородностью внутреннего магнитного поля и различием затухания магнитоупругой и немагнитоупругой волн в области малых полей (менее 0,5 кЭ). Достаточно сильный рост затухания при повышении частоты от 10 до 45 МГц, по-видимому, также объясняется рассеянием на внутренних неоднородностях.

Зависимость скорости и поляризации от магнитного поля позволяет управлять поляризацией магнитоупругой волны в гематите. Результирующий вектор смещения сдвиговой волны, распространяющейся в направлении z, на выходе кристалла может быть представлен как сумма двух нормальных волн

$$u_1 = u_0 \cos 2\varphi \cos \left[2\pi f \left(t - l/v_1 \right) \right], \tag{7}$$

$u_2 = u_0 \sin 2\varphi \cos[2\pi f(t - l/v_2)],$

где v_1 и v_2 определяются формулами (4), l — размер кристалла вдоль оси z, f — частота. В общем случае поперечная волна будет эллиптически поляризована. Параметры эллипса определяются амплитудами нормальных мод и разностью фаз

$$\Delta \Phi = \frac{2\pi f \left(v_2 - v_1 \right) l}{v_1 v_2}.$$

При $\Delta \Phi = (2n+1)\pi/2$ будет наблюдаться круговая поляризация, при $\Delta \Phi = n\pi$ эллипс вырождается в прямую. Если амплитуды u_1 и u_2 одинаковы (т. е. $2\varphi = 45^{\circ}$), то равенство $\Delta \Phi = (2n+1)\pi$ выражает условие поворота поляризации на 90° от параллельной оси **x**, заданной на входе, до перпендикулярной оси **x** на выходном преобразователе. Отсюда легко найти соответствующую такой разности фаз скорость магнито-упругой волны:

$$v_1 = \frac{2flv_2}{2fl + v_2(2n+1)}$$

и из формул (2), (4) или из графика v(H) (см. рис. 1) определить необходимое управляющее поле. Подставляя l=2 мм, $v_2=4\cdot10^5$ см \cdot с⁻¹, f=12 МГц, n=0, получим величину напряженности поля, необходимую для поворота плоскости поляризации на 90°, равную 2,6 кЭ. Из экспериментальной зависимости амплитуды прошедшего импульса от угла φ , приведенной на рис. 3, видно, что при H=2,6 кЭ амплитуда практи-



Рис. 3. Зависимость амплитуды волны от направления магнитного поля (О – 2,6 кЭ; Δ – 1,4 кЭ; \times – 0,625 кЭ)





чески уменьшается до нуля, когда $\varphi = 22,5^{\circ}$ (67,5°). Значению H = 1,4 кЭ соответствует $\Delta \Phi = 2\pi$. В этом случае независимо от направления внешнего поля амплитуда и поляризация на выходе кристалла сохраняются, в то время как скорость меняется от $3,5 \cdot 10^5$ см · c⁻¹ ($\varphi = 0$) до $4 \cdot 10^5$ см · c⁻¹ ($\varphi = 45^{\circ}$). При дальнейшем уменьшении поля на характер зависимостей влияет различие затухания магнитоупругой и упругой моды. На рис. 4 показаны графики изменения амплитуды параллельной и перпендикулярной оси **x** компонент поляризации от угла φ для

H=2,6 кЭ, которые демонстрируют поворот плоскости поляризации на 90°. Аналогичного эффекта управления поляризацией волны в гематите можно добиться, меняя величину магнитного поля при φ =const. Такие экспериментальные зависимости приведены на рис. 5. Уменьше-



ние глубины модуляции амплитуды при снижении поля объясняется в основном различием затухания нормальных мод, что эквивалентно различию амплитуд складывающихся волн (7), и, очевидно, может быть компенсировано изменением угла ф.

Проведенные исследования показали, что затухание и поляриза-

Рис. 5. Зависимость амплитуд параллельной и перпендикулярной оси х компонент поляризации от напряженности магнитного поля ($\varphi = 22.5^\circ$; f = 45 МГц)

ция магнитоупругих волн в гематите сильно зависят от величины и направления внешнего магнитного поля. Эти эффекты могут быть использованы для создания магнитоакустических устройств с управляемой поляризацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Seavey M. H. Solid State Comm., 1972, 10, р. 219. [2] Максименков П. П., Ожогин В. И. ЖЭТФ, 1973, 65, с. 657. [3] Бережнов В. В., Евтихиев Н. Н., Преображенский В. Л., Экономов Н. А. Радиотехн. и электроника, 1983, № 2, с. 376. [4] Лямов В. Е. Поляризационные эффекты и анизотропия взаимодействия акустических воли в кристаллах. М.: Изд-во МГУ, 1983. [5] Ожогин В. И., Преображенский В. Л. ЖЭТФ, 1977, 73, с. 989.

> Поступила в редакцию 25.09.84

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1985, Т. 26, № 5

УДК 536.758

о тройных корреляциях в жидкостях

П. В. Елютин

(кафедра квантовой радиофизики)

Задача определения последовательности *n*-частичных функций распределения $g_n(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., \mathbf{r}_n)$ является одной из основных в статистической механике [1]. Двухчастичная функция $g_2(r_{12})$, определяющая в системе с парным взаимодействием большинство равновесных термодинамических свойств, может быть вычислена из экспериментальных данных по рассеянию. Трехчастичную функцию распределения g_3 представим в виде

$$g_3(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3) = G\chi, \quad G = g_2(r_{12})g_2(r_{23})g_2(r_{31}).$$

Она несет информацию об угловых корреляциях и входит в выражения, определяющие производные от g_2 по термодинамическим параметрам, что дает возможность экспериментального определения некоторых функционалов от g_2 [2].

Априорно функция х должна быть инвариантна при перестановке